









	<h2 style="color: red;">FQD8P10TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD8P10TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD8P10TF.pdf 2.FQD8P10TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD8P10TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 6.6A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	530 mOhm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD8P10TF ist neu im Original, Suche FQD8P10TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD8P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD8P10TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD8P10 FAIRCHI FQD8P10 FAIRCHI</p>	 <p>FQD8P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p>	 <p>FQD8P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p>	 <p>FQD8N25 FAIRCHILD FQD8N25 FAIRCHILD</p>
 <p>FQD8P10TF_NB82052 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p>	 <p>FQD8N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 6.2A DPAK</p>	 <p>FQD8P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p>	 <p>FQD8N60 FSC FQD8N60 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD6P25TM	↔ FQD6P25TM	⇒ FQD7N10L	D FQD7N10LTF	⇒ FQD7N10LTF
⊕ FQD7N10LTM	⊗ FQD7N10LTM	D FQD7N10TF	⇒ FQD7N10TM	⇒ FQD7N10TM
⊗ FQD7N20L	⊕ FQD7N20LTF	⊗ FQD7N20LTF	↔ FQD7N20LTM	⇒ FQD7N20LTM
D FQD7N20TF	⊗ FQD7N20TF	⊕ FQD7N20TM	⊗ FQD7N20TM	⇒ FQD7N30TM
⇒ FQD7N30TM	↔ FQD7P06TF	⊗ FQD7P06TF	⊕ FQD7P06TM	⇒ FQD7P06TM
↔ FQD7P06TM_F080	⇒ FQD7P06TM_F080	D FQD7P06TM_NB82050	⊗ FQD7P06TM_NB82050	⊕ FQD7P10TF
⊗ FQD7P20TF	D FQD7P20TF	⇒ FQD7P20TM	↔ FQD7P20TM	⇒ FQD7P20TM_F080
⊕ FQD7P20TM_F080	⊗ FQD8P10TF	↔ FQD8P10TF_NB82052	⇒ FQD8P10TF_NB82052	⇒ FQD8P10TM
⊗ FQD8P10TM	⊕ FQD8P10TM_	⊗ FQD8P10TM_F080	D FQD8P10TM_F080	⇒ FQD8P10TM_F085
↔ FQD8P10TM_SB82052	⊗ FQD8P10TM_SB82052	⊕ FQD9N08L	⊗ FQD9N25TM	⇒ FQD9N25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited